Зона	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание	
		<u>Конденсаторы</u>			
	C1,C7	Конденсатор многослойный 10 нФ 250 В			
		±10% X7R	2		
	C2, C5,	Конденсатор многослойный 100 нФ 50 В			
	C9	±10% X7R	3		
	C3, C8,	Конденсатор многослойный 47 нФ 50 B ±10%			
	C10	X7R	3		
	C4	Конденсатор многослойный 22 мкФ 25 В			
		±20% X7R	1		
	<i>C</i> 6	Конденсатор многослойный 100 пФ 50 В			
		± 5% C0G	1		
	C11	Конденсатор многослойный 10.5 пФ 50 В			
		± 5% NP0	1		
		<u>Микросхемы</u>			
	BMS	HX-2S-JH20, система управления батареи	1		
	VCO	YSGM232508, генератор управляемый			
		напряжением	1		
	DC-DC	XL6009, преобразователь, повышающий	1		
	LVC	LM2940L-50-TN3-R, линейный регулятор			
		напряжения	1		
	LED1	0805G, светодиод зелёный 120° 100 мКд			
		474 нм	1		
	FAN1	RQU3510MS, вентилятор-улитка, 0.15 A,			
		0.75 Bm, 7000 об./мин.	1		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		<u>Резисторы</u>			
	R1. R3	<u>— — — — — — — — — — — — — — — — — — — </u>			
	R4	, ,	3		
		5,45,400004.0			
ГУИР.400201.024 ПЭЗ Изм. Лист № докум. Подп. Дата					
Разр	Разраб. Григорик Аппаратный комплекс для		Лит.	Лист Листов	
Пров. Куприянова Т. контр. Куприянова Н. контр. Туровец Утв. Никульшин Никульшин Турова Теречень элементов			ЭВ	1 2 М, гр. 050503	

Зона	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание		
	R2, R5	Резистор SMD 150 Ом, 0.5 Вт, ±5%	2			
	R6, R11	Резистор SMD 22 кОм, 0.125 Bm, ±1%	2			
	R7	Резистор SMD 100 Ом, 1 Вт, ±5%	1			
	R8, R9	Резистор подстроечный 1 кОм, 0.5 Bm,				
		±10%	2			
	R10	Терморезистор 22 кОм, 0.5 Вт, ±2%	1			
		<u>Аккумуляторы</u>				
	B1B2	EVE-ICR18650/26V аккумулятор литий-				
		ионный, 2550 мАч, 5 А	2			
		<u>Транзисторы</u>				
	VT1VT4	MMBT2222A, NPN-Транзистор, 50 B, 0.8 A	4			
		<u>Разъемы</u>				
	RF-SMA	КН-SMA-K513-G, RF-вывод на SMA-антенну				
		шаг 2.54мм, 5 контактов	1			
	USB-C	GT-USB-7010ASV, USB 2.0 type-C female,				
		Крепление на плату	1			
				Лист		
Ш	ГУИР.400201.024 ПЭЗ					

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата